

平成 22 年 9 月 24 日

委員各位

日本学術振興会  
結晶加工と評価技術第 145 委員会  
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会  
第 124 回研究会 開催通知

日時： 2010 年 10 月 19 日 (火) 13:00 ~ 17:30  
会場： 明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン A4 会議室  
[http://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)  
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)  
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分  
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分  
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「モビリティ・ブースター・テクノロジー」

世話人：酒井 朗 (大阪大学)、小椋厚志 (明治大学)

本研究会では、Si-CMOS 開発におけるポストスケーリングの重要技術である、MOSFET チャンネルのキャリアモビリティを向上させるための、歪、材料、デバイス構造形成の各技術と、それに関わる評価技術の最先端と将来動向を概観する。

プログラム

- 13:00~13:05 開会の挨拶 田島道夫
- 13:05~13:10 はじめに 酒井 朗
- 13:10~13:50 「次世代 CMOS のチャンネル・基板技術の開発と将来展望」  
財満鎮明 (名古屋大学)
- 13:50~14:30 「先端半導体デバイスと基板を軸とした材料開発」  
松川和人 (ルネサスエレクトロニクス(株))
- 14:30~15:10 「シリコンナノワイヤの作製と FET 応用」  
角嶋邦之<sup>1</sup>, 佐藤創志<sup>1</sup>, 岩井洋<sup>1</sup>, 大毛利健治<sup>2</sup>, 山田啓作<sup>2</sup> (<sup>1</sup>東京工業大学, <sup>2</sup>早稲田大学)
- 15:10~15:30 休憩
- 15:30~16:10 「酸化濃縮 SiGe-On-Insulator 基板の欠陥評価と制御」  
中島 寛 (九州大学)
- 16:10~16:50 「EBSD 法による格子歪測定技術の紹介」  
鈴木清一 (株)TSL ソリューションズ)
- 16:50~17:30 「先端デバイス開発に向けた高輝度放射光評価」  
木村 滋 ((財)高輝度光科学研究センター)
- 18:00~20:00 懇親会 (場所：明治大学駿河台キャンパス リバティータワー23 階 サロン燦)

以上